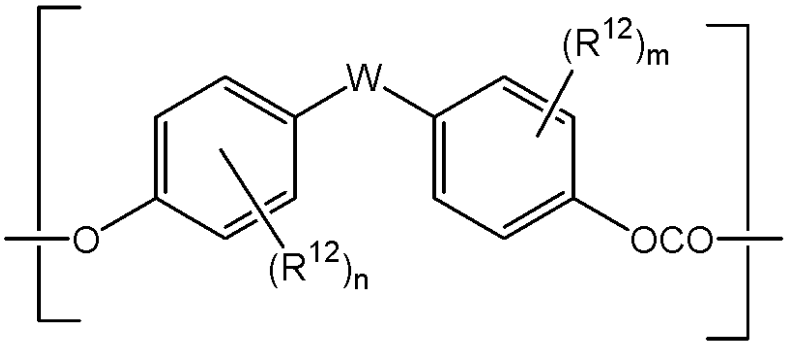
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成18年9月28日(2006.9.28)

【公表番号】特表2006-503157(P2006-503157A)
【公表日】平成18年1月26日(2006.1.26)
【年通号数】公開・登録公報2006-004
【出願番号】特願2004-545235(P2004-545235)
【国際特許分類】
Ｃ０８Ｇ　64/22　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０８Ｇ　64/22

【手続補正書】
【提出日】平成18年8月8日(2006.8.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
芳香族ポリカーボネートの製造方法であって、当該方法は界面重合条件下でオリゴマークロロホルメートを含む溶液を酸受容体及び触媒と接触させることを含んでなり、前記オリゴマークロロホルメート溶液はクロロホルメート基の総濃度、芳香族ヒドロキシル基の全濃度、及びクロロホルメート基の正味濃度を有しており、前記クロロホルメート基の正味濃度はクロロホルメート基の総濃度と芳香族ヒドロキシル基の全濃度との差であり、前記クロロホルメート基の正味濃度は前記溶液１リットル当たりクロロホルメート基０．０４モルを超える値を有する、方法。
【請求項２】
前記クロロホルメート基の正味濃度が前記溶液１リットル当たりクロロホルメート基０．０４～０．１２モルの範囲内にある、請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記接触が流通反応器系内で実施される、請求項１記載の方法。
【請求項４】
前記流通反応器系が、１以上の管形反応器、１以上の連続攪拌槽形反応器、１以上のループ反応器、１以上のカラム反応器又はこれらの組合せを含む、請求項３記載の方法。
【請求項５】
前記接触がバッチ反応器系内で実施される、請求項１記載の方法。
【請求項６】
前記バッチ反応器系が攪拌槽形反応器である、請求項５記載の方法。
【請求項７】
前記オリゴマークロロホルメートが次式の構造（IV）を有する繰返し単位を含む、請求項１記載の方法。

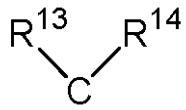
【化１】



IV

（式中、R^{12}は各々独立にハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、C_1～C_{20}アルキル基、C_4～C_{20}シクロアルキル基又はC_6～C_{20}アリール基であり、ｎ及びｍは独立に０～４の整数であり、Ｗは結合、酸素原子、硫黄原子、SO_2基、C_1～C_{20}脂肪族基、C_6～C_{20}芳香族基、C_6～C_{20}脂環式基又は次式の基である。）

【化２】

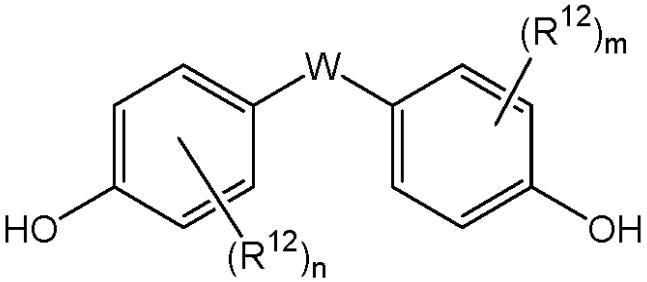


（式中、R^{13}及びR^{14}は独立に水素原子、C_1～C_{20}アルキル基、C_4～C_{20}シクロアルキル基又はC_4～C_{20}アリール基であり、或いはR^{13}及びR^{14}は一緒になって、１以上のC_1～C_{20}アルキル基、C_6～C_{20}アリール基、C_5～C_{21}アラルキル基、C_5～C_{20}シクロアルキル基又はこれらの組合せで任意に置換されるC_4～C_{20}脂環式環を形成する。）

【請求項８】

繰返し単位（IV）を含む前記オリゴマークロロホルメートが、界面条件下でのホスゲンを次式の構造（Ｖ）を有する１種以上のビスフェノールと反応させることで製造される、請求項７記載の方法。

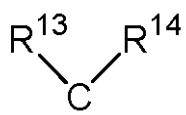
【化３】



V

（式中、R^{12}は各々独立にハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、C_1～C_{20}アルキル基、C_4～C_{20}シクロアルキル基又はC_6～C_{20}アリール基であり、ｎ及びｍは独立に０～４の整数であり、Ｗは結合、酸素原子、硫黄原子、SO_2基、C_1～C_{20}脂肪族基、C_6～C_{20}芳香族基、C_6～C_{20}脂環式基又は次式の基である。）

【化４】



（式中、R^{13}及びR^{14}は独立に水素原子、C_1～C_{20}アルキル基、C_4～C_{20}シクロアルキ

ル基又はC_4～C_{20}アリール基であり、或いはR^{13}及びR^{14}は一緒になって、１以上のC_1～C_{20}アルキル基、C_6～C_{20}アリール基、C_5～C_{21}アラルキル基、C_5～C_{20}シクロアルキル基又はこれらの組合せで任意に置換されるC_4～C_{20}脂環式環を形成する。）

【請求項９】

芳香族ポリカーボネートの製造方法であって、

段階（ａ）オリゴマークロロホルメートを含む溶液を流通反応器内に連続的に導入する段階であって、前記溶液はクロロホルメート基の総濃度、芳香族ヒドロキシル基の全濃度、及びクロロホルメート基の正味濃度を有しており、前記クロロホルメート基の正味濃度はクロロホルメート基の総濃度と芳香族ヒドロキシル基の全濃度との差であり、前記クロロホルメート基の正味濃度は前記溶液１リットル当たりクロロホルメート基０．０４モルを超える値を有する、段階と、

段階（ｂ）前記流通反応器内に酸受容体及び触媒を連続的に導入する段階と、

段階（ｃ）生成物芳香族ポリカーボネートを含む流出液を連続的に取り出す段階と

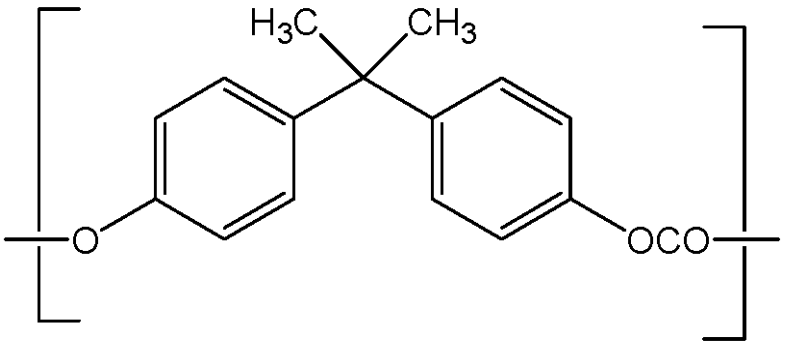
を含んでなる方法。

【請求項１０】

ビスフェノールＡポリカーボネートの製造方法であって、

段階（ａ）オリゴマークロロホルメートを含む塩化メチレン溶液を流通反応器内に連続的に導入する段階であって、前記溶液はクロロホルメート基の総濃度、芳香族ヒドロキシル基の全濃度、及びクロロホルメート基の正味濃度を有しており、前記クロロホルメート基の正味濃度はクロロホルメート基の総濃度と芳香族ヒドロキシル基の全濃度との差であり、前記クロロホルメート基の正味濃度は前記溶液１リットル当たりクロロホルメート基０．０４～０．１２モルの値を有し、前記オリゴマークロロホルメートは次式の構造（VII）を有する繰返し単位を含む、段階と、

【化５】



VII

段階（ｂ）前記流通反応器内に水酸化ナトリウムの水溶液及びトリエチルアミン触媒の塩化メチレン溶液を連続的に導入する段階と、

段階（ｃ）生成物芳香族ポリカーボネートを含む流出液を連続的に取り出す段階と

を含んでなる方法。